



www.jdsemi.cn

深圳市晶导电子有限公司
ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

CM2N60C
POWER MOSFET

◆ 600V N-Channel VDMOS

◆ 使用及贮存时需防静电

◆ 符合 RoHS 等环保指令要求

1. 主要用途

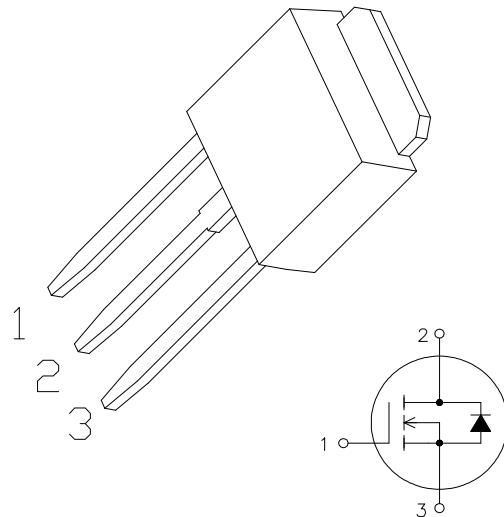
主要用于充电器、LED 驱动、PC 辅助电源等各类功率开关电路

2. 主要特点

- 开关速度快
- 通态电阻小，输入电容小

3. 封装外形

TO-251



4. 电特性

4.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$

参数名称	符号	额定值	单位
漏源反向电压	V_{DSS}	600	V
连续漏极电流	I_D	2.0	A
漏极脉冲电流	I_{DM}	8.0	A
栅源电压	V_{GS}	± 30	V
单脉冲雪崩能量	E_{AS}	80	mJ
热阻 (结到壳)	$R_{\theta JC}$	4.46	$^{\circ}C/W$
耗散功率($T_a=25^{\circ}C$)	P_{tot}	28	W
结温	T_j	150	$^{\circ}C$
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}C$

4.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250 \mu A$	600			V
通态电阻	$R_{DS(on)}^*$	$V_{GS}=10V, I_D=1A$		3.4	4	Ω
阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250 \mu A$	2		4	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$			25	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V$			± 100	nA
源漏二极管正向压降	V_{SD}^*	$I_S=2A, V_{GS}=0V$			1.5	V
关断延迟时间	$t_{d(off)}$	$V_{DD}=300V, I_D=2A$ $R_G=18 \Omega, V_{GS}=10V$		33		ns
输入电容	C_{iss}	$V_{GS}=0V, V_{DS}=25V$ $f=1.0MHz$		280		pF

* 脉冲测试 : $t_p \leq 300\mu s, \delta \leq 2\%$

* $L=10mH, I_D=2A, T_j=25^{\circ}C$

5. 特性曲线

图 1 安全工作区 (直流)

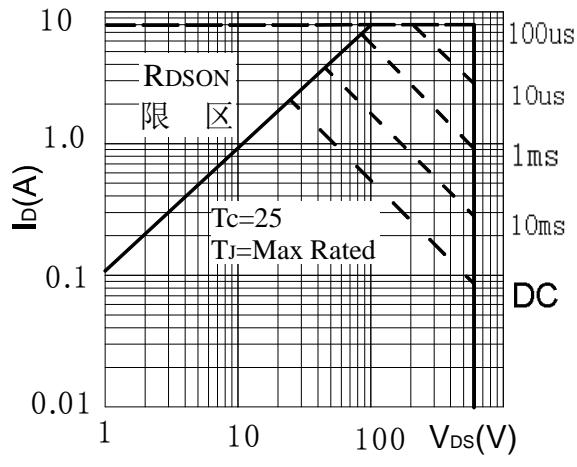


图 2 $P_{tot} - T$ 关系曲线

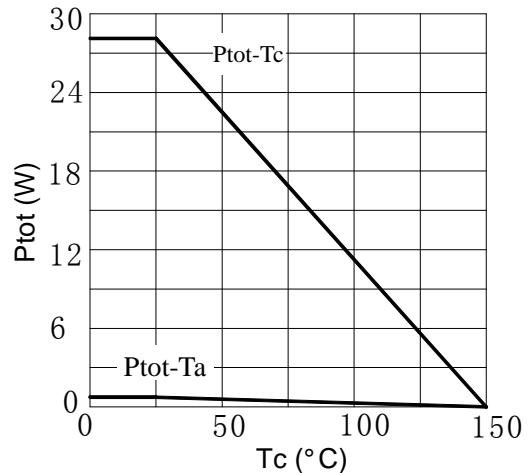


图 传 曲 线

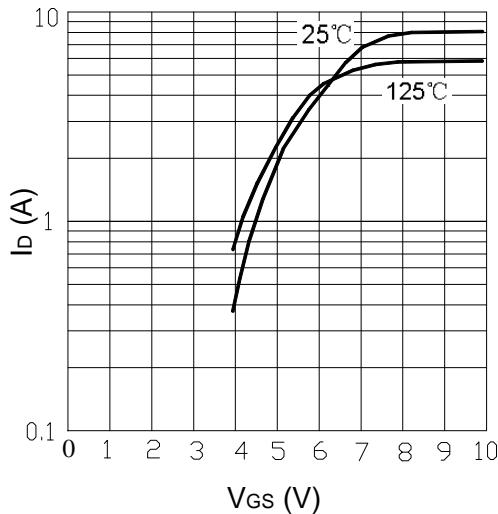


图 电 - 关系曲线

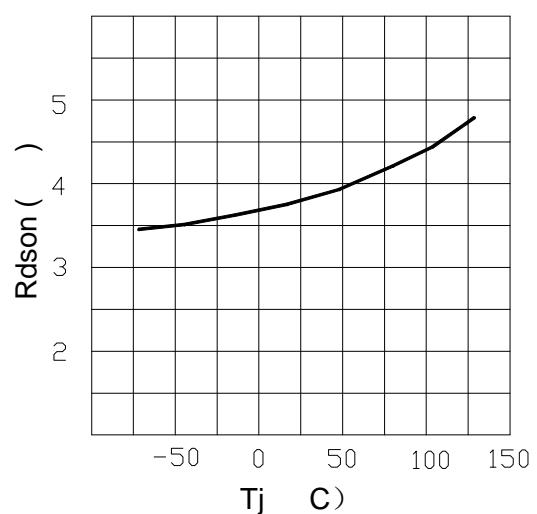


图 电 - 关系曲线

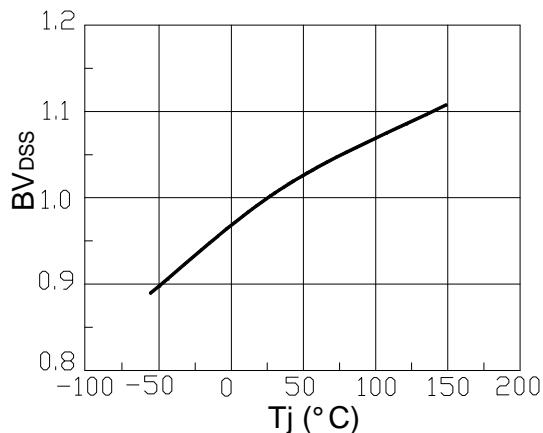
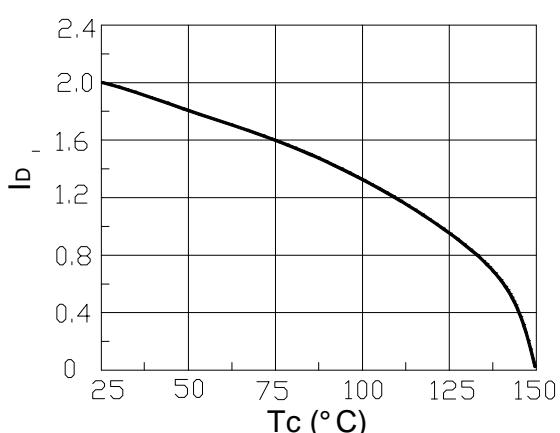


图 电 流 - 关系曲线





www.jdsemi.cn

深圳市晶导电子有限公司
ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

CM2N60C
POWER MOSFET

6. 产品外形尺寸图(单位: mm)

T0-251

